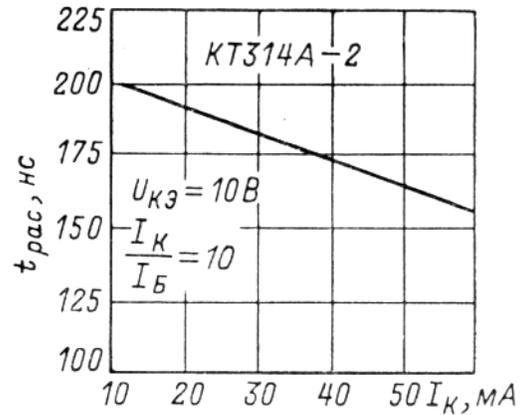


Зависимость времени рассасывания от тока коллектора.



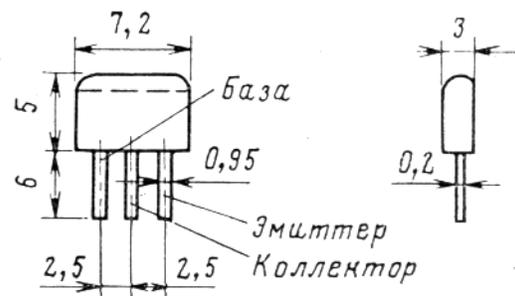
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315К, КТ315И

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* усиленные высокочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах усилителей высокой, промежуточной и низкой частоты.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,18 г.



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_Э = 5 \text{ мА}$ не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15 В (V)
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30 В (V)
КТ315Г, КТ315Е	25 В (V)

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20 \text{ мА}$, $I_Б = 2 \text{ мА}$ не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	0,4 В (V)
КТ315Д, КТ315Е	1 В (V)
КТ315Ж	0,5 В (V)

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 20 \text{ мА}$, $I_Б = 2 \text{ мА}$ не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	1,1 В (V)
КТ315Д, КТ315Е	1,5 В (V)
КТ315Ж	0,9 В (V)

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_K = 1 \text{ мА}$:

КТ315А, КТ315В, КТ315Д	20 — 90
----------------------------------	---------

КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е	50 – 350
КТ315Ж	30 – 250
КТ315И не менее	30
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ} = 10В$, $I_{Э} = 5$ мА не более:	
КТ315А	300 нс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г	500 нс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	1000 нс
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 1$ мА, $f = 100$ МГц не менее:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	2,5
КТ315Ж	1,5
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 10$ МГц не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И	7 пФ
КТ315Ж	10 пФ
Входное сопротивление при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 1$ мА не менее	
	40 Ом
Выходная проводимость при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 1$ мА	
	0,3 мксм
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не бо- лее	
	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} = U_{КЭ.макс}$ не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е.	1 мкА
КТ315Ж	10 мкА
КТ315И	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	30 мкА
КТ315И	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $T = 213 \div 373$ К:	
КТ315А	25 В (V)
КТ315Б	20 В (V)
КТ315В, КТ315Д	40 В (V)
КТ315Г, КТ315Е	35 В (V)
КТ315Ж	15 В (V)
КТ315И	60 В (V)
Постоянное напряжение база-эмиттер при $T = 213 \div 373$ К	
	6 В (V)
Постоянный ток коллектора при $T = 213 \div 373$ К:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е	100 мА
КТ315Ж, КТ315И	50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
 $T = 213 \div 298 \text{ К}$:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,	
КТ315Е	150 мВт
КТ315Ж, КТ315И	100 мВт
Температура перехода	393 К
Температура окружающей среды	От 213 до 373 К

Примечания: 1. Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 298 \div 373 \text{ К}$ определяется по формуле

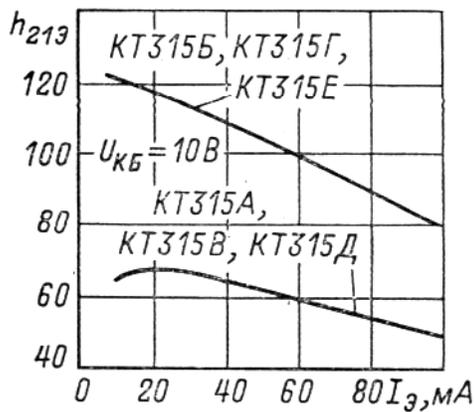
$$P_{\text{К.макс}} = (393 - T)/0,67.$$

Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_{\text{К}} = 250 \text{ мВт}$ при $U_{\text{КБ}} = 12,5 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 20 \text{ мА}$.

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от корпуса транзистора.

При включении транзистора в схему, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен подсоединяться первым и отсоединяться последним.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем интервале температур.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы.

